

## Presseinformation

### **Infineon stellt neues TO-Leadless-Gehäuse vor – entwickelt für Hochstrom-Anwendungen bis zu 300 A**

Neubiberg, 14. Mai 2013 – Infineon Technologies hat heute ein neues TO-Leadless-Gehäuse vorgestellt, das neben einem reduzierten Package-Widerstand signifikant geringere Abmessungen und ein verbessertes EMV-Verhalten bietet. In dem Gehäuse verbirgt sich die neueste OptiMOS™ MOSFET-Generation für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit wie Gabelstapler, leichte Elektrofahrzeuge, elektronische Sicherungen (eFuse), Spannungsregler-Module (Point-of-Load-Converter) und Telekom-Systemen.

Das neue TO-Leadless-Gehäuse wurde für hohe Stromstärken bis zu 300 A entwickelt. Dank seines reduzierten Package-Widerstands ermöglicht es den geringsten Durchlasswiderstand  $R_{DS(on)}$  in allen Spannungsklassen. Das im Vergleich zu einem 7-poligen D<sup>2</sup>PAK um 60 Prozent kleinere Gehäuse ermöglicht sehr kompakte Designs. Das TO-Leadless-Gehäuse bietet eine signifikante Verringerung der Grundfläche um 30 Prozent und benötigt beispielsweise entsprechend weniger Leiterplattenfläche in Gabelstaplern. Die um 50 Prozent reduzierte Gehäusehöhe bietet zudem weitere Vorteile in kompakten Anwendungen wie in Schaltschränken oder Blade-Servern. Darüber hinaus ermöglicht die geringe parasitäre Induktivität ein verbessertes EMV-Verhalten.

„Mit dem neuen TO-Leadless-Gehäuse ist Infineon der erste Halbleiterhersteller, der einen 60-V-MOSFET mit nur 0,75 mΩ anbietet. Damit kann beispielsweise die Anzahl der erforderlichen parallelen MOSFETs in einem Gabelstapler reduziert und die Leistungsdichte erhöht werden“, sagte Richard Kuncic, Leiter des Produktsegments Low Voltage Power Conversion bei Infineon Technologies. „Das neue Gehäuse bietet unseren Kunden signifikante Vorteile für High-Power-Anwendungen, die höchste Effizienz und Zuverlässigkeit erfordern.“

Außerdem verfügt das neue TO-Leadless-Gehäuse über einen um 50 Prozent größeren Lötkontaktbereich, was zu einer geringeren Stromdichte führt. Damit kann die Elektromigration bei hohen Strömen und hohen Temperaturen verhindert

werden, zugunsten einer verbesserten Zuverlässigkeit. Im Unterschied zu anderen leadless Gehäusen erlaubt die besondere Form der Anschlüsse im TO-Leadless eine optische Inspektion der Lötung.

Das neue Gehäuse ist prädestiniert für High-Power-Anwendungen, die höchste Effizienz, ausgezeichnete Zuverlässigkeit, sehr gutes EMV- und thermisches Verhalten erfordern.

### **Verfügbarkeit**

Muster der TO-Leadless-Bausteine sind für 30 V (0,4 mΩ max.), 60 V (0,75 mΩ max.), 100 V (2,0 mΩ max.) und 150 V (5,9 mΩ max.) verfügbar, während Volumenstückzahlen für das 3. Quartal 2013 geplant sind.

Weitere Informationen über die neue Familie von Infineon im TO-Leadless-Gehäuse findet man unter: [www.infineon.com/toll](http://www.infineon.com/toll)

### **Über Infineon**

Die [Infineon](http://www.infineon.com) Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: [Energieeffizienz](#), [Mobilität](#) sowie [Sicherheit](#). Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2012 (Ende September) einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter [www.infineon.com](http://www.infineon.com).

Diese Presseinformation finden Sie unter [www.infineon.com/presse](http://www.infineon.com/presse).